

シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ  
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

捷多邦 专业PCB打样工厂 24小时  
加急出货

2SD428

○ 電力増幅用

o Power Amplifier Applications

- ・ コレクタ損失が大きい。 :  $P_C = 60W$
- ・ 高耐圧です。 :  $V_{CEO} = 100V$
- ・ 2SB558 とコンプリメンタリになります。
- ・ 40W Hi-Fi オーディオアンプ出力段に最適です。

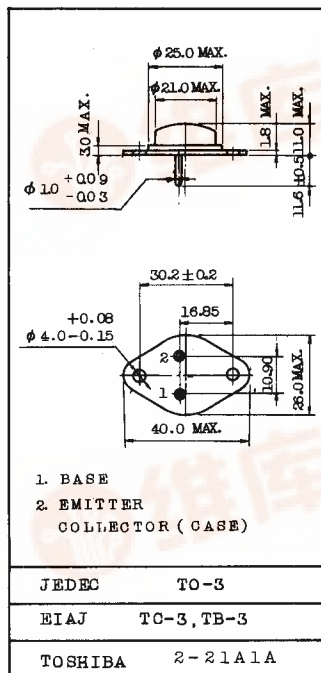
Complementary to 2SD428

- ・ Recommended for 40W High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ C$ )

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	100	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	7	A
エミッタ電流	$I_E$	-7	A
コレクタ損失	$P_C$	60	W
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-65~150	$^\circ C$

Unit in mm



アクセサリは AC 73 を適用  
MOUNTING KIT NO. AC 73

# 2SD428

## 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25 °C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタ・エミッタ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CE}=50V, I_E=0$	—	—	100	$\mu A$
エミッタ・エミッタ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	100	$\mu A$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=0.1A, I_E=0$	100	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10mA, I_C=0$	5	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note)	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	40	—	140	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5V, I_C=5A$	15	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5A, I_E=0.5A$	—	—	2.5	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=5V, I_C=5A$	—	—	2.0	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE}=5V, I_E=-1A$	—	7	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CE}=10V, I_E=0$ $f = 1MHz$	—	140	—	pF

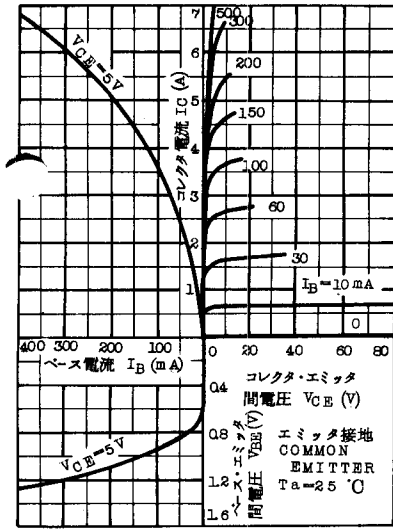
Note;  $h_{FE(1)}$  により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of  $h_{FE(1)}$ , the 2SD428 is classified as follows.

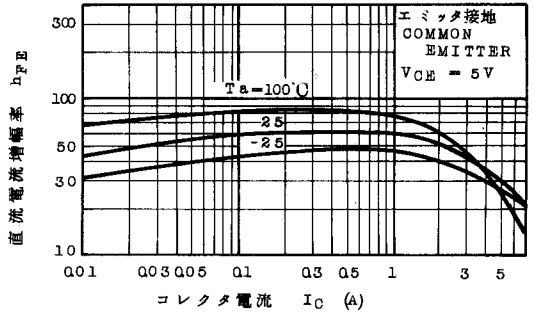
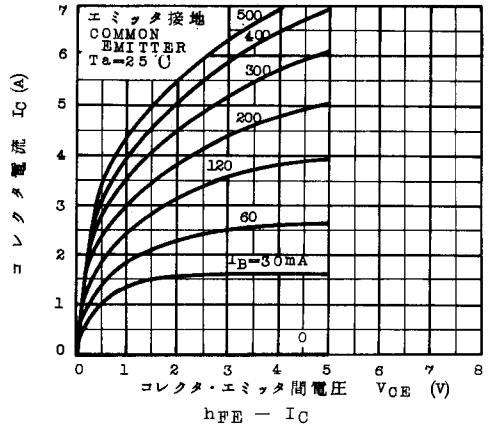
CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SD428-R	40	80
2SD428-O	70	140

# 2SD428

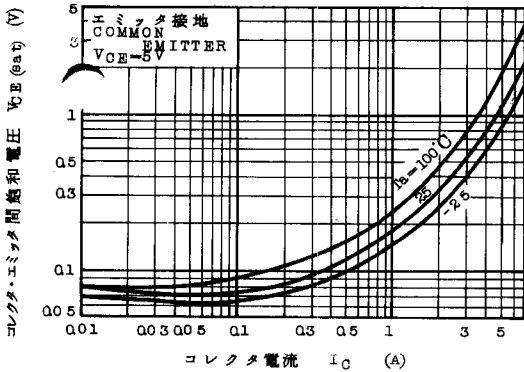
STATIC CHARACTERISTICS



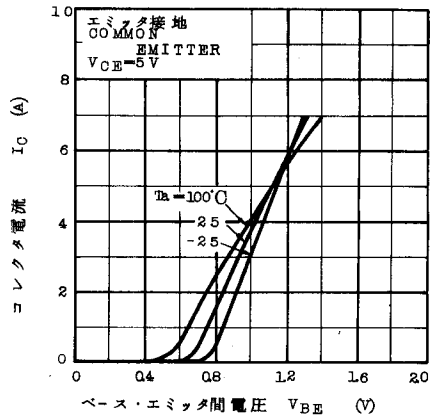
$I_C - V_{CE}$  (LOW VOLTAGE REGION)



$V_{CE}(\text{sat}) - I_C$

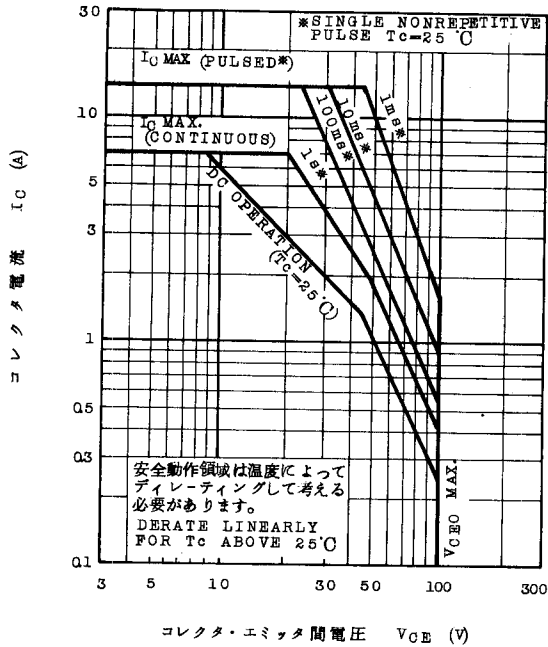


$I_C - V_{BE}$

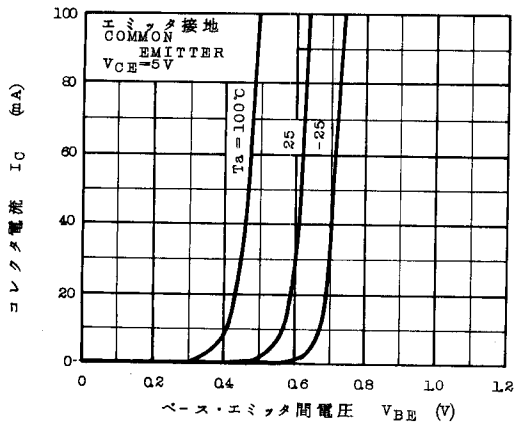


# 2SD428

## 安全動作領域 ASO



## $I_C$ - $V_{BE}$ (LOW CURRENT REGION)



## $P_C$ - $T_a$

